

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形トランジスタ

2SD356, 2SD357, 2SD358

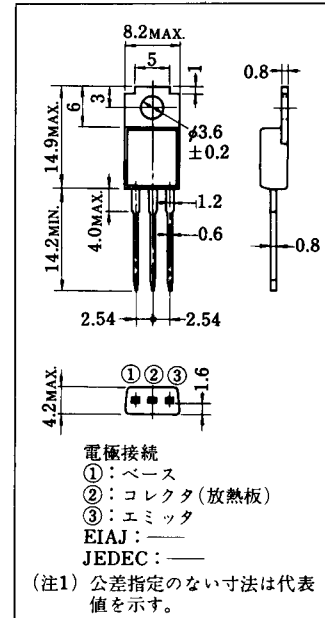
40~70W出力 コンプリメンタリドライブ用

- 高耐圧 ($V_{CEO}=80V, 100V, 120V$)。
- 破壊耐量が大きい。
- h_{FE} の直線性が良い。
- モールドパワートランジスタで、小形かつ取付けが容易です。
- 2SB526, 2SB527, 2SB528とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

最大定格 (周囲温度 25°C)

項目	記号	定格値			単位
		2SD356	2SD357	2SD358	
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	90	110	130	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	5	5	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	80	100	120	V
コレクタ電流	I_C	800			mA
コレクタ損失	$T_a=25^\circ\text{C}$	P_C			W
	$T_c=25^\circ\text{C}$	P_C			W
接合部温度	T_j	+150			°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150			°C

外形図 単位: mm



電気的特性 (周囲温度 25°C)

項目	記号	測定条件	2SD356			2SD357			2SD358			単位
			最小	標準	最大	最小	標準	最大	最小	標準	最大	
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$	90	—	—	110	—	—	130	—	—	V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	5	—	—	5	—	—	5	—	—	V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}, R_{BE}=\infty$	80	—	—	100	—	—	120	—	—	V
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=25\text{V}, I_E=0$	—	—	10	—	—	10	—	—	10	μA
コレクタしや断電流	I_{CEO}	$V_{CE}=80\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	1	—	—	—	—	—	—	mA
コレクタしや断電流	I_{CEO}	$V_{CE}=100\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	—	—	—	1	—	—	—	mA
コレクタしや断電流	I_{CEO}	$V_{CE}=120\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	—	—	—	—	—	—	1	mA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	—	—	10	—	—	10	—	—	10	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=0.3\text{A}$, パルステスト	55	100	300	55	100	300	55	100	300	—
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=0.3\text{A}, I_B=0.03\text{A}$	—	—	1	—	—	1	—	—	1	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=0.05\text{A}$	—	0.7	—	—	0.7	—	—	0.7	—	V

h_{FE} の値により下表のようにアイテム分類を行なっています。

アイテム	C	D	E
h_{FE}	55~110	90~180	150~300